

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К ЖУРНАЛУ «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»
 Том 26, 1992 год

	Стр.
1. Обзоры	2171
2. Структура, механические и термические свойства полупроводников (PACS 60)	2171
2.1. Структура полупроводников, кристаллография (PACS 61)	2171
2.1.1. Аморфные и стеклообразные полупроводники (PACS 61.40)	2171
2.1.2. Дефекты в полупроводниках (PACS 61.70)	2171
2.1.3. Ионная имплантация (PACS 61.70)	2173
2.1.4. Радиационные дефекты (PACS 61.80)	2173
2.1.5. Структура поверхности границ раздела тонких пленок (PACS 68)	2174
3. Электронная структура. Электрические, магнитные и оптические свойства полупроводников (PACS 70)	2174
3.1. Электронные состояния (PACS 71)	2174
3.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)	2175
3.2. Транспортные явления (PACS 72)	2176
3.2.1. Генерация, рекомбинация, время жизни носителей заряда (PACS 72.27JV)	2177
3.2.2. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)	2177
3.3. Электронная структура и электрические свойства поверхности границ раздела и тонких пленок (PACS 73)	2178
3.3.1. Контактные явления (PACS 73.30; 73.40)	2179
3.4. Магнитные свойства полупроводников, магнитные резонансы (PACS 75.76)	2181
3.5. Оптические свойства полупроводников. Взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)	2181
3.5.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)	2182
3.5.2. Рекомбинационное рассеяние (PACS 78.30)	2182
3.5.3. Фотолюминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)	2182
3.5.4. Оптические свойства поверхности границ раздела тонких пленок (PACS 78.65)	2183
4. Получение и применение полупроводников (PACS 80)	2184
4.1. Методы получения, термообработка и травление полупроводников (PACS 81)	2184
4.2. Применение полупроводников, полупроводниковые приборы (PACS 85)	2184
4.3. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55)	2185
5. Юбилеи и даты	2185
6. Информация о новых книгах, конференциях	2185

Трансмутационное легирование полупроводников под действием заряженных частиц (обзор). Козловский В. В., Захаренков Л. Ф., Шустров Б. А. 1, 3

Пары Френкеля в германии и кремнии (обзор). Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович В. В. 1, 22

Резонансное рассеяние носителей тока в полупроводниках типа $A^{IV}B^{VI}$ (обзор). Кайданов В. И., Немов С. А., Равич Ю. И. 2, 201

Полупроводниковые структуры с δ -слоями (обзор). Шик А. Я. 7, 1161

2. Структура, механические и термические свойства полупроводников (PACS 60)

2.1. Структура полупроводников, кристаллография (PACS 61)

Получение и исследование пленок SiO_2 , активированных полупроводниковыми нанокристаллами CdS . Гуревич С. А., Екимов А. И., Кудрявцев И. А., Осинский А. В., Скопина В. И., Чепик Д. И. 1, 102

Рекомбинация носителей заряда в термообработанном Si с различными типами ростовых микродефектов. Колковский И. И., Латышенко В. Ф., Лугаков П. Ф., Шуша В. В. 1, 176

Фотоэлектрические свойства эпитаксиальных пленок $Pb_{1-x}Sn_xS$ и структур на их основе, обусловленные микро- и макронеоднородностями. Горшкова О. В., Дрозд И. А., Стафеев В. И. 3, 510

Влияние нарушения стехиометрии на экситонные, электронные и колебательные состояния в дифосфиде цинка. Сырбу Н. Н. 6, 1069

Угол связи $Si-O-Si$ в монокристалле кремния. Сорока В. И., Арцимович М. В., Могиляник И. Ф. 9, 1547

Икосаэдрические бориды и аморфный бор. Голикова О. А. 9, 1604

Некоторые закономерности и новые возможности интеркалированных халькогенидных полупроводников. Козымяк И. Д., Нетяга В. В., Бахматюк Б. П., Григорчак И. И., Ковалюк З. Д. 11, 1993

Влияние структуры и фазового состава на фотоэлектрические характеристики пленок $Pb_{1-x}Sn_xS < Na >$. Бакуева Л. Г., Захарова И. Б., Ильин В. И., Мусихин С. Ф. 11, 2011

Реконструкция глубинной структуры микротрещин в кремнии с помощью метода томографии и наведенного тока в растровом электронном микроскопе. Выборнов В. В., Бондаренко И. Е., Лихарев С. К., Трифоненков В. П. 12, 2076

2.1.1. Аморфные и стеклообразные полупроводники (PACS 61.40)

Фотопроводимость и плотность состояний аморфного гидрированного кремния, легированного бором. Голикова О. А., Бабаходжаев У. С., Дубров В. В., Икрамов Р. Г., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Яфаев Р. Р. 1, 66

Исследование электропереноса дырок в аморфном гидрированном кремнии методом фотоВАХ. Голикова О. А., Икрамов Р. Г., Казанин М. М. 1, 71

Магнитные спиновые эффекты на фотопроводимости аморфного As_2Se_3 . Кадыров Д. И., Минаев В. С., Франкевич Е. Л. 2, 373

Структурная сетка $a-Si$: H, легированного бором, и транспорт дырок. Голикова О. А., Мездрогина М. М., Соколов А. П., Шебанин А. П. 5, 960

Статические характеристики тонкопленочных полевых транзисторов на основе $a-Si$: H. Греков Е. В. 7, 1256

Фотоиндуцированные эллиптические двулучепреломление и дихроизм в стеклообразных полупроводниках. Тихомиров В. К. 8, 1415

Влияние статистического сдвига уровня Ферми на электропроводность $a-Si$: H: нормальное и аномальное правило Мейера—Нелдела. Сорокина К. Л. 8, 1500

Состояние оборванных связей в псевдолегированном аморфном гидрированном кремнии $a-Si$: H. Голикова О. А., Сорокина К. Л. 8, 1511

О природе эффекта псевдолегирования в $a-Si$: H. Лигачев В. А., Филиков В. А. 9, 1540

Влияние структурной неоднородности на проводимость и релаксационные процессы в $a-Si$: H и $a-Si_{1-x}N_x$: H. Айвазов А. А., Будаган Б. Г., Мейтин М. Н., Становов О. Н. 9, 1585

Икосаэдрические бориды и аморфный бор. Голикова О. А. 9, 1604

Применение метода насыщения сигналов электронного парамагнитного резонанса для исследования аморфного гидрированного карбида кремния переменного состава. Карягин С. Н., Константинова Е. А. 12, 2129

2.1.2. Дефекты в полупроводниках (PACS 61.70)

Пары Френкеля в германии и кремнии (обзор). Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович В. В. 1, 22

Долговременные релаксации проводимости, обусловленные фотостимулированной диффузией кислорода по межзерненным

- границ в пленках сульфида кадмия. Панонов В. П., Панова Г. Д., Шейнкман М. К. 1, 95
- Непереоориентируемая дивакансия в кремнии. Жалко-Титаренко И. В., Крайчинский А. Н., Рогуцкий И. С. 1, 180
- Характер изменения свойств $PbTe<Ga>$ при изменении степени легирования. Белоконь С. А., Верещагина Л. Н., Иванчик И. И., Рябова Л. И., Хохлов Д. Р. 2, 264
- О природе точечных дефектов, генерируемых при диффузии акцепторных примесей в карбиде кремния. Константинов А. О. 2, 270
- О причине возникновения приповерхностного плато диффузионного профиля фосфора в кремнии. Константинов А. О. 2, 339
- Роль дефектов в акцепторном легировании полупроводников типа $PbTe$ элементами I группы. Алексеева Г. Т., Земсков Б. Г., Константинов П. П., Прокофьева Л. В., Уразбаева К. Т. 2, 358
- Образование глубоких центров в GaAs при лазерном облучении. Дмитриев А. Г., Дорин В. А., Карфул Р., Погарский М. А., Шульга М. И. 2, 397
- Метастабильность центров марганца в твердых растворах кремний—германий. Баграев Н. Т., Мирсаатов Р. М., Половцев И. С., Сирожов У., Юсупов А. 3, 427
- Образование и свойства термодоноров при отжигах ниже 550 °С в кристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского. Бабич В. М., Баран Н. П., Доценко Ю. П., Зотов К. И., Ковальчук В. Б., Максименко В. М. 3, 447
- Цинк в кремнии: фотоиндуцированные реакции. Баграев Н. Т., Мирсаатов Р. М., Половцев И. С., Юсупов А. 3, 481
- Кинетика образования термодоноров в кристаллах $Si<Ge, O>$. Бринкевич Д. И., Маркевич В. П., Мулин Л. И., Петров В. В. 4, 682
- Положение и зарядовое состояние примеси европия в решетке селенида свинца. Громовой Ю. С., Пляцко С. В., Кадышев С. К. 4, 778
- Влияние дислокаций, образованных лазерным облучением, на электрофизические и люминесцентные свойства $p-CdTe$. Байдуллаева А., Булах Б. М., Даулетмуратов Б. К., Джумаев Б. Р., Корсунская Н. Е., Мозоль П. Е., Горягдьева Г. 5, 801
- Фотолюминесценция сильно легированного арсенида галлия при упорядоченном распределении примесных комплексов. Богданова В. А., Семиколенова Н. А., 5, 818
- Механизм снижения плотности дислокаций при изовалентном легировании полупроводниковых соединений $A^{III}B^{V}$. Мартисов М. Ю. 5, 822
- $Si_{1-x}Ge_x$ самокомпенсация двойных акцепторов цинка в твердых растворах кремний—германий. Баграев Н. Т., Мирсаатов Р. М., Половцев И. С., Сирожов У., Юсупов А. 5, 836
- О природе «аномальных» DLTS-спектров в монокристаллах германия с дислокациями. Бочкарева Н. И., Рувимов С. С. 5, 872
- Дислокации в $AlGaAs/GaAs$ -сверхрешетке. Трусова И. А., Поляков М. Е. 6, 979
- Нелинейные свойства ВАХ и ВФХ для стенок из заряженных дислокаций. Шикина Ю. В., Шикин В. Б. 6, 992
- Об акцепторно-донорных свойствах дислокаций в полупроводниках p -типа. Шикина Ю. В., Шикин В. Б. 6, 997
- Геттерирование в кремнии в условиях генерации вакансий. Амальская Р. М., Баграев Н. Т., Клячкин Л. Е., Суханов В. Л. 6, 1004
- Влияние избыточного давления паров компонентов на ансамбль точечных дефектов в кристаллах CdS . Крюкова И. В., Теплицкий В. А., Шульга Е. П., Джумаев Б. Р., Корсунская Н. Е. 6, 1054
- Исследование преобразования дефектов в кристаллах $CdTe$ при кратковременном отжиге методом люминесцентного профилирования. Бабенцов В. Н., Рашковецкий Л. В., Сальков Е. А., Гарбаев Н. И. 6, 1088
- Состояние водорода и механизмы пассивации примесей и радиационных дефектов в кристаллическом кремнии. Мукашев Б. Н., Тамендаров М. Ф., Токмолдин С. Ж. 6, 1124
- Лазерно-стимулированная диффузия золота в кремнии. Закиров А. С., Игамбердыев Х. Т., Мамадалимов А. Т., Хабибуллаев П. К. 7, 1282
- Самокомпенсация электроактивных примесей собственными дефектами в твердых растворах $Pb_{0.9}Sn_{0.1}Te$. Немов С. А., Равич Ю. И., Житинская М. К., Прошин В. И. 8, 1493
- О механизме отжига дивакансий в кремнии, облученном протонами. Берман Л. С., Воронков В. Б., Козлов В. А., Ременюк А. Д. 8, 1507
- Угол связи $Si-O-Si$ в монокристалле кремния. Сорока В. И., Арцимович М. В., Могильник И. Ф. 9, 1547
- Исследование структурных дефектов в эпитаксиальных слоях арсенида индия. Баранов А. Н., Воронина Т. И., Гореленок А. А., Лагунова Т. С., Литвак А. М., Сиповская М. А., Старосельцева С. П., Тихомирова В. А., Шерстнев В. В. 9, 1612
- Перераспределение магния в $InAs$ при постимплантационном отжиге. Герасименко Н. Н., Мясников А. М., Ободников В. И., Сафронов Л. Н. 9, 1651
- Влияние отжига на спектр глубоких центров захвата в $ZnSe$. Оконечников А. П., Мельник Н. Н. 9, 1659
- Изовалентное легирование фосфида индия галлием и мышьяком в процессе жидкофазной эпитаксии. Пышная Н. Б., Радауцан С. И., Чалдышев В. В., Чумак В. А., Шмарцев Ю. В. 10, 1737

- Эффект дальнего действия в монокристаллах GaAs с различной плотностью дислокаций. Кладыко В. П., Крыштаб Т. Г., Свидельский А. В., Семенова Г. Н. 11, 1932
- Влияние неравновесных собственных точечных дефектов на образование электрически активных центров в кремниевых $p-n$ -структурах при термообработке. Выжигин Ю. В., Соболев Н. А., Грессеров Б. Н., Шек Е. И. 11, 1938
- Глубокие уровни термодфектов в высокоомном особо чистом n -кремнии. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 11, 1962
- Восходящая диффузия примеси при ионном облучении нагретого кремния: численное моделирование. Качурин Г. А., Гадиак Г. В., Шатров В. И., Тыщенко И. Е. 11, 1978
- Фотостимулированное изменение положения Mn^{2+} в кристаллической решетке селенида свинца. Громовой Ю. С., Кадышев С. К., Пляцко С. В. 12, 2098
- Диффузия заряженных примесей в варизонных полупроводниках. Монастырский Л. С., Соколовский Б. С. 12, 2143

2.1.3. Ионная имплантация (PACS 61.70)

- Влияние условий ионной имплантации на дефектообразование в кремнии. Жуковский П. В. 1, 150
- Влияние ионной имплантации компенсирующей примеси на оптические свойства n -GaAs. Венгер Е. Ф., Гончаренко А. В., Дмитрук Н. Л., Прокофьев А. Ю., Фидря Н. А. 2, 352
- Распределение концентрации мелких и глубоких заряженных центров в ионно-легированных бериллием слоях фосфида индия. Абрамов А. А., Захариков Л. П., Микуленок А. В., Стоянова И. Г. 3, 500
- Спектроскопия КРС ионно-имплантированных слоев GaAs. Артамонов В. В., Валах М. Я., Громашевский В. Л., Нечипорук Б. Д., Стрельчук В. В., Юхимчук В. А. 4, 725
- Низкотемпературная электропроводность ионно-имплантированного фосфором и сурьмой кремния. Абрамов В. В., Кульбачинский В. А., Кытин В. Г., Тимофеев А. Б., Уляшин А. Г. 5, 878
- Влияние температуры отжига имплантированного хлором кремния на образование электрически активных комплексов. Омельяновская Н. М., Краснобаев Л. Я. 6, 1116
- Эффект дальнего действия в полуизолирующих полупроводниках GaAs и InP при облучении ионами аргона. Павлов П. В., Демидов Е. С., Карзанов В. В. 6, 1148
- Влияние двойной имплантации атомов кремния и фтора на электрофизические параметры полуизолирующего арсенида галлия. Бумай Ю. А., Малаховская В. Э., Уляшин А. Г., Шлопак Н. В., Самойлюк Т. Т., Никитина Т. Д., Горупа К. С., Автюшков Е. В., 7, 1306
- Рост монокристаллического α -Si₃N₄ в закороненных слоях, полученных низкоинтенсивной имплантацией ионов N⁺ в нагретый кремний. Качурин Г. А., Тыщенко И. Е., Плотноков А. Е., Попов В. П. 8, 1390
- Об аномальной дозовой зависимости концентрации VV-центров в кремнии при ионной имплантации азота. Лобанова Н. Е., Карзанов В. В., Тетельбаум Д. И. 8, 1514
- Перераспределение магния в InAs при постимплантационном отжиге. Герасименко Н. Н., Мясников А. М., Ободников В. И., Сафронов Л. Н. 9, 1651
- Прыжковая проводимость ионно-имплантированного серой кремния. Кульбачинский В. А., Кытин В. Г., Абрамов В. В., Тимофеев А. Б., Уляшин А. Г., Шлопак Н. В. 10, 1801
- Воздействие света на процесс имплантации ионов R⁺ в Si. Артамонов В. В., Валах М. Я., Денисов А. В., Мордкович В. Н., Нечипорук В. Д. 12, 2083

2.1.4. Радиационные дефекты (PACS 61.80)

- Трансмутационное легирование полупроводников под действием заряженных частиц (обзор). Козловский В. В., Захаренков Л. Ф., Шустров Б. А. 1, 3
- Нейтронное облучение Cd_xHg_{1-x}Te. Иванов-Омский В. И., Кухтев Н. В., Смирнов В. А., Юлдашев Ш. У., Гадаев О. А. 3, 420
- Шум $1/f$, электрические и фотоэлектрические свойства GaAs, подвергнутого облучению ионами высокой энергии. Гусинский Г. М., Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. 3, 543
- Процессы образования радиационных дефектов в Si : Ge при 4.2, 78 и 300 К. Голубев В. Г., Емцев В. В., Клигер П. М., Кропотов Г. И., Шмарцев Ю. В. 3, 574
- Влияние радиационных дефектов, введенных α -частицами на обратные токи кремниевых $p-n$ -переходов. Александров О. В., Шевченко Б. Н., Матханова И. П., Каменец А. В. 5, 868
- Резонансная зона радиационных дефектов в сплаве p -Pb_{1-x}Sn_xTe ($x=0.2$), облученном электронами. Брандт Н. Б., Скипетров Е. П., Хорosh А. Г. 5, 888

- Кинетические свойства кристаллов n -ZnSe с радиационными дефектами. Блажку А. И., Джуади Д., Касиян В. А., Мосейчук Г. С., Недеогло Д. Д. 5, 900
- Состояние водорода и механизмы пассивации примесей и радиационных дефектов в кристаллическом кремнии. Мукашев Б. Н., Тамендаров М. Ф., Токмолдин С. Ж. 6, 1124
- Особенности отжига компенсирующих радиационных дефектов в бездислокационном n -кремнии. Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф. 6, 1142
- Эффект дальнего действия в полупроводниках GaAs и InP при облучении ионами аргона. Павлов П. В., Демидов Е. С., Карзанов В. В. 6, 1148
- Пассивация радиационных дефектов в гидрогенизированных слоях кремния при нейтронном облучении. Болотов В. В., Плотников Г. Л., Эмексузян В. М., Шмальц К. 7, 1295
- Модель радиационного накопления дефектов в системе кремний—оксид кремния. Крылов Д. Г., Ладыгин Е. А., Галеев А. П. 7, 1347
- О корреляционном механизме двухуровневой рекомбинации в γ , e -облученном кремнии. Дикман С. М. 8, 1427
- Влияние предварительной термообработки на эффективность образования радиационных дефектов в бездислокационном кремнии. Лугаков П. Ф., Лукьяница В. В. 8, 1509
- Светодиоды на основе карбида кремния, облученного быстрыми электронами. Водаков Ю. А., Гирка А. И., Константинов А. О., Мохов Е. Н., Роенков А. Д., Свирида С. В., Семенов В. В., Соколов В. И., Шишкин А. В. 11, 1857
- Влияние редкоземельных элементов на энтропию и энтропию ионизации радиационных дефектов в германии, легированном фосфором. Алимов О. М., Петров В. В., Харченко Т. Д., Явид В. Ю. 11, 1914
- Центры дилатации в облученном электронами кремнии. Кустов В. Е., Ройцин А. Б., Трипаченко Н. А., Шаховцов В. И. 11, 1928
- Образование и отжиг радиационных дефектов в пленках p -Pb_{0.76}Sn_{0.24}Te при протонном облучении. Фреик Д. М., Салий Я. П., Рувинский М. А., Горичок И. Я., Фреик А. Д., Добровольская А. М. 12, 2103

2.1.5. Структура поверхности границ раздела тонких пленок (PACS 68)

- Полупроводниковые структуры с δ -слоями (обзор). Шик А. Я. 7, 1161
- Выращивание квантовых кластеров GaAs—AlAs на ориентированных не по (100) фасетированных поверхностях GaAs методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Алфёров Ж. И., Егоров А. Ю., Жуков А. Е., Иванов С. В., Копьев П. С., Леденцов Н. Н., Мельцер Б. Я., Устинов В. М. 10, 1715
- Определение однородности квантовых ям на основе InGaAs/GaAs по фотомодуляционным спектрам. Авруцкий И. А., Осауленко О. П., Плотниченко В. Г., Пырков Ю. Н. 11, 1907

3. Электронная структура. Электрические, магнитные и оптические свойства полупроводников (PACS 70)

- Получение и свойства изотипных гетероструктур на основе n -CuInSe₂. Магомедов М. А., Медведкин Г. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. 3, 556
- Локализация и делокализация в $Pb_{1-x}Sn_xTe<In>$, индуцированные сверхсильным магнитным полем и ИК подсветкой. Де Виссер А., Иванчик И. И., Никорич А. В., Хохлов Д. Р. 6, 1034
- Электрические свойства эпитаксиальных слоев марганец—ртуть—теллур p -типа. Трифонова М. М., Барышев Н. С., Мезенцева М. П., Ахмедова Ф. И., Аверьянов И. С. 7, 1327
- Электрические, термоэлектрические и магнитные свойства $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$, легированного индием. Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Радченко М. В., Мирец А. Л., Паренская Е. С., Никитин М. С., Растегин Ю. И., Колесник С. П. 10, 1768

3.1. Электронные состояния (PACS 71)

- Экситоны в квантовых ямах с двумерным электронным газом. Пикус Ф. Г. 1, 45
- Самосогласованная релятивистская электронная структура соединений AzV . Королева О. С., Чулков Е. В. 2, 223
- О влиянии индия на энергетические спектры $Pb_{1-x}Sn_xTe$. Абрамян Ю. А., Папазян К. З., Стафеев В. И. 2, 257
- Анализ зависимости ширины запрещенной зоны от состава $Pb_{1-x}Sn_xSe_{1-y}Te_y$, изо-периодического с PbSe, в рамках p -модели. Бычкова Л. П., Даварашвили О. И., Шотов А. П. 2, 280
- Температурная зависимость энергии связи экситонов Ваннье—Мотта в квантовых ямах.

Алешкин В. Я., Костин А. А., Романов Ю. А. 2, 18
 Энергия связи экситонов в магнитосмешанных полупроводниках в магнитном поле. Семенов Ю. Г., Стефанович В. А. 2, 324
 Концентрация собственных носителей и эффективная масса электронов в $Mn_xHg_{1-x}Te$. Боднарк О. А., Горбатиук И. Н., Остапов С. Э., Раренко И. М. 3, 468
 Фотоиндуцированное образование центров поверхностной рекомбинации в арсениде галлия. Гукасян А. М., Ушаков В. В., Гиппиус А. А., Марков А. В. 3, 525
 Особенности валентных зон некоторых соединений $A^IV \cdot$ Сырбу Н. Н., Камерцель А. Ю., Стамов И. Г. 4, 669
 Резонансные состояния в легированных и нелегированных кристаллах теллурида свинца. Дарчук С. Д., Коровина Л. А., Сизов Ф. Ф. 5, 845

Поллярные параметры в полупроводниках выращенным краем валентной зоны. Гифейсман Ш. Н., Коропчану В. П. 5, 949
 Электрические свойства экстрагированного теллурида кадмия. Савицкий А. В., Ткачук В. И., Ткачук П. Н. 5, 952
 Влияние нарушения стехиометрии на экситонные, электронные и колебательные состояния в дифосфиде цинка. Сырбу Н. Н. 6, 1069
 К вопросу о собственной концентрации носителей заряда в твердых растворах $Cd_xHg_{1-x}Te$. Карачевцева Л. А., Любченко А. В. 7, 1342
 Переход металл—диэлектрик в магнитном поле в сильно легированном антимониде. Аронзон Б. А., Дричко И. Л. 8, 1446
 Матрица переноса одномерного уравнения Шредингера. Чуприков Н. Л. 12, 2040

3.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)

Структура примесного центра марганца в антимониде галлия. Георгиц Е. И., Гуцуляк Л. М., Иванов-Омский В. И., Мастеров В. Ф., Смирнов В. А., Штельмах К. Ф. 1, 89
 Метастабильность центров марганца в твердых растворах кремний—германий. Баграев Н. Т., Мирсаатов Р. М., Половцев И. С., Сиров У., Юсупов А. 3, 427
 К вопросу о корреляционной функции в релаксационной спектроскопии глубоких уровней. Шматов А. А. 3, 473
 Цинк в кремнии: фотоиндуцированные реакции. Баграев Н. Т., Мирсаатов Р. М., Половцев И. С., Юсупов А. 3, 481
 Акцепторные уровни замещающих атомов примеси меди в кристаллах $Ge_{1-x}Si_x$. Аджаров Г. Х., Кязым-заде Р. З., Мир-Багиров В. В. 3, 553
 Положение и зарядовое состояние примеси европия в решетке селенида свинца. Громоной Ю. С., Пляцко С. В., Кадышев С. К. 4, 778
 Повышение разрешения в релаксационной спектроскопии глубоких уровней с двухканальным строб-интегратором. Гордеев Д. М., Шмагин В. Б. 5, 955
 О природе «аномальных» DLTS-спектров в монокристаллах германия с дислокациями. Бочкарева Н. И., Рувимов С. С. 5, 872
 Равновесные параметры глубоких объемных уровней в антимониде индия. Шемелина О. С., Новотоцкий-Власов Ю. Ф. 6, 1015
 Симметрия комплекса $V_{Ga}Te_{As}$ в $GaAs$ и его переориентация при низких температурах. Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Решиков М. А., Сосновский В. Р. 7, 1269
 Модификация спектра мелких состояний арсенида галлия под действием импульсного лазерного излучения. Кашкаров П. К., Тимошенко В. Ю. 7, 1321

Туннельно-термическая перезарядка глубоких уровней в барьере Шоттки. I. Вольт-амперные характеристики. Гергель В. А., Тарнавский С. П. 7, 1330
 Туннельно-термическая перезарядка глубоких уровней в барьере Шоттки. II. Дисперсия малосигнальных характеристик. Гергель В. А., Тарнавский С. П. 7, 1335
 Примесные состояния In в $GeTe$. Березин А. В., Житинская М. К., Немов С. А., Черник И. А. 8, 1405
 ДЭЯР и электронная структура примесных центров бора в $6H-SiC$. Петренко Г. Л., Тесленко В. В., Мохов Е. Н. 9, 1556
 Влияние условий эксперимента на результаты обработки DLTS-спектров методом анализа формы линии. Комаров Б. А. 9, 1625
 О втором донорном уровне междоузельного хрома в кремнии. Демидов Е. С., Карзанов В. В. 9, 1656
 Оптимизация корреляционной процедуры в методах термостимулированной релаксационной спектроскопии полупроводников. Вывенко О. Ф., Истратов А. А. 10, 1693
 Спектр мелкого акцептора в полумангнитном полупроводнике в магнитном поле. Иванов-Омский В. И., Харченко В. А., Цыпишка Д. И. 10, 1728
 Изовалентное легирование фосфида индия галлием и мышьяком в процессе жидкофазной эпитаксии. Пышная Н. Б., Радауцан С. И., Чалдышев В. В., Чумак В. А., Шмарцев Ю. В. 10, 1737
 Электронное состояние примеси индия в узкощелевых полупроводниках $Pb_{0.82}Sn_{0.18}Te$, $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$. Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Мирец А. Л., Зыков Г. А. 10, 1825
 Интерпретация неравновесных емкостных спектров A -центров, вводимых при импульсной фотонной обработке кремния. Белявский В. И., Капустин Ю. А., Свиридов В. В. 10, 1832

Примесный центр в частично заполненной d -оболочкой в бинарном полупроводнике. Ильин Н. П., Мастеров В. Ф., Васильев А. Э. 11, 1866

Основное состояние переходных элементов группы железа в арсениде и фосфиде галлия. Ильин Н. П., Васильев А. Э., Мастеров В. Ф. 11, 1878

Резонансные состояния, образованные примесями кобальта и никеля в селениде ртути. Цидильковский И. М., Леринман Н. К., Сабирзянова Л. Д., Паранчич С. Ю., Паранчич Ю. С. 11, 1894

3.2. Транспортные явления (PACS 72)

Особенности распространения «внутренних» электростатических волн в неоднородной плазмоподобной среде. Басс Ф. Г., Булгаков А. А., Ханкина С. И. 1, 140

О связи между порогами протекания в теории протекания. Кязым-заде А. Г. 1, 169

Резонансное рассеяние носителей тока в полупроводниках типа A^IVB^IV (обзор) Кайда-нов В. И., Немов С. А., Равич Ю. И. 2, 201

Механизм высокоскоростного переключения в арсенид-галлиевых структурах с глубокими центрами. Хлудков С. С., Толбанов О. П. 2, 386

Осцилляции Шубникова — де-Гааза в p -ZnSb. Арушанов Э. К., Рознован Ю. В., Шубников М. Л., Смирнов Д. В., Машовец Д. В. 2, 395

Образование шнура проводимости и пробоя в поликристаллическом оксиде индия. Соловьева А. Е. 3, 408

Прыжковая проводимость $K = 0.3$ -серии образцов $Ge : Ga$: эффект насыщения, переоскоки по ближайшим соседям и переход к прыжкам с переменной длиной. Забродский А. Г., Андреев А. Г., Алексеенко М. В. 3, 431

Особенности магнитопольевых зависимостей кинетических коэффициентов в двухслойных структурах $Cd_xHg_{1-x}Te$. Караченцева Л. А., Любченко А. В., Маловичко Э. А. 3, 535

Низкотемпературные аномалии термоэдс $PbTe <P>$. Бойко М. П., Засавицкий Е. А. 3, 568

Исследование объемных и поверхностных кинетических свойств кристаллов n - $Hg_{1-x}Cd_xTe$ в области температур $0.5 < T < 50$ К. Вертий А. А., Горбатюк И. Н., Иванченко И. В., Попенко Н. А., Пустыльник О. Д., Раренко И. М., Тарапов С. И. 4, 585

Магнитосопротивление сверхрешеток в сильных полях. Аскеров Б. М., Кулиев Б. И., Панахов М. М. 4, 755

Влияние примеси индия на электрофизические свойства $Pb_{1-x}Sn_xTe$ при $x > 0.3$. Андроник К. И., Бойко М. П., Никорич А. В. 5, 839

Магнитотермоэдс $Mn_{0.18}Hg_{0.82}Te$. Гаджалиев М. М. 5, 915

Глубокие уровни термодиффектов в высокоомном особо чистом n -кремнии. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 11, 1962

Спектр состояний мелкого донора в сверхрешетках $(GaAs)_n(InAs)_m$. Шегай О. А., Мошегов Н. Т., Палкин А. М., Торопов А. И. 11, 1989

Об акцепторных уровнях дивакансии в кремнии. Коршунов Ф. П., Маркевич В. П., Медведева И. Ф., Мурын Л. И. 11, 2007

Краевая энергетическая релаксация в квантовом эффекте Холла. Шик А. Я. 5, 955

Определение сечения фотоионизации легирующих примесей в полупроводниках из измерений эффекта Холла. Веденеев А. С., Ждан А. Г., Рыльков В. В., Шафран А. Г. 6, 1096

Квантовые когерентные эффекты в германии, легированном мышьяком. Бильгильдеева Т. Ю., Полянская Т. А. 6, 1109

Аномальный фото-холл-эффект в кристаллах p -InAs. Гусев О. К., Киреенко В. П., Яржембицкий В. Б. 6, 1138

Получение дырочной проводимости в монокристаллах селенида цинка. Краснов А. Н., Ваксман Ю. Ф., Пуртов Ю. Н., Сердюк В. В. 6, 1151

Вольт-амперные характеристики и эффект переключения в низкоомное состояние в $PbTe <Ga>$ при низких температурах. Акимов Б. А., Албул А. В., Богданов Е. В., Ильин В. Ю. 7, 1300

Электрические и фотолюминесцентные свойства эпитаксиальных слоев $GaSb <Bi>$ и $GaSb <Bi, Sn>$, полученных из висмутовых растворов. Акчурун Р. Х., Жегалин В. А., Чалдышев В. В. 8, 1409

Теоретическая модель туннельного дисперсионного транспорта в неупорядоченных материалах. Никитенко В. Р. 8, 1438

Влияние статистического сдвига уровня Ферми на электропроводность α -Si : H нормальное и аномальное правило Мейера—Неддела. Сорокина К. Л. 8, 1500

Неустойчивости тока в фотосопротивлении на основе кремния, легированного селеном. Чистохин И. Б., Тишковский Е. Г., Герасименко Н. Н. 9, 1529

Низкочастотные колебания тока в комбинированном цинком кремнии. Бахадурханов М. К., Зикриллаев Н. Ф., Арзикулов Э. У. 9, 1536

Хаотические автоколебания в варизонных полупроводниковых структурах. Владимиров В. В., Горшков В. Н., Малютенко В. К. 9, 1580

Влияние структурной неоднородности на проводимость и релаксационные процессы в α -Si : H и α - $Si_{1-x}N_x$: H. Айвазов А. А., Будагян Б. Г., Мейтин М. Н. 9, 1585

Отрицательный фотоакустический эффект в стеклообразном селениде мышьяка. Рыков В. В., Харионовский А. В., Вывенко О. Ф. 9, 1653

Перераспределение концентрации инжектированных носителей заряда в искусственно анизотропной полупроводниковой пластине с кольцевыми электродами. Бабичев Г. Г., Гузь В. Н., Жадько И. П., Козловский С. И., Романов В. А. 10, 1723

Прыжковая проводимость ионно-имплантированного серой кремния. Кульбачинский В. А., Кытин В. Г., Абрамов В. В., Тимофеев А. Б., Ульяшин А. Г., Шлопак Н. В. 10, 1801

Механизм тензоэффекта в n -Si(Mn) при всестороннем гидростатическом сжатии. Абдураимов А., Зайнабидинов С. З., Тешабаев А., Маматкаримов О. О., Химматкулов О. 10, 1845

3.2.1. Генерация, рекомбинация, время жизни носителей заряда (PACS 72.20 JY)

Влияние компенсирующего отжига на шум $1/f$ в $Cd_xHg_{1-x}Te$. Бакши И. С., Карачевцева Л. А., Любченко А. В., Петряков В. А., Сальков Е. А., Хижняк Б. И. 1, 173

Рекомбинация носителей заряда в термообработанном Si с различными типами ростовых микродефектов. Колковский И. И., Латышенко В. Ф., Лугаков П. Ф., Шуша В. В. 1, 176

К вопросу о шумах в полупроводниковых структурах с инжекционной неустойчивостью. Иддис Б. Г., Фролов В. Д. 1, 187

Шум дефектов обратно смещенных n - p -переходов на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$. Андрухив М. Г., Белотелов С. В., Вирт И. С., Шкумбатюк П. С. 2, 393

Упругое рассеяние в многодолинных полупроводниках и его роль в релаксации энергии неравновесных электронов. Прима Н. А. 3, 530

Шум $1/f$, электрические и фотозлектрические свойства $GaAs$, подвергнутого облучению ионами высокой энергии. Гусинский Г. М., Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. 3, 543

Внутризонное излучение электронов в высокочастотном поле и неравновесные фононы. Амиров Р. Х., Зудеев О. Г. 4, 592

Возникновение нормального электрического поля при ускоренном дрейфовом движении носителей заряда в полупроводнике с постоянным током. Апсит А. Р. 10, 1850

Термоэдс и термоток монополярных полупроводников ограниченных размеров. Гуревич Ю. Г., Логвинов Г. Н. 11, 1945

Магнитотермоэдс $Mn_{0.06}Hg_{0.94}Te$ при одноосной деформации. Гаджиалиев М. М., Мусаев А. М. 11, 1952

Влияние давления на электропроводность и эффект Холла селенида индия. Исмаилов А. А., Гасысов Ш. Г., Мамедов Т. С., Аллахвердиев К. Р. 11, 1995

Электрические свойства монокристаллов p -ZnSe. Краснов А. Н., Вахсан Ю. Ф., Пуртов Ю. Н. 11, 2001

Акустоэлектрический эффект в системах с локализованными состояниями в режиме моттовской проводимости. Бокачева Л. С., Гальперин Ю. М. 11, 2003

Изотермические термоактивационные токи в монокристаллах $CaGa_2S_4$: E4. Асланов Г. К., Тагиев О. Б., Иззатов Б. М. 4, 703

Излучательная и безызлучательная рекомбинация в четверных твердых растворах $Pb_{1-x}Sn_xSe_{1-y}Te_y$. Даварашвили О. И., Караваев Г. Ф., Катаев С. Г., Тюттерев В. Г. 5, 906

Исследование рекомбинационных процессов неравновесных носителей заряда в эпитаксиальных слоях арсенида галлия. Йодказис С., Пятраускас М., Нятикшис В., Утенко В. 8, 1394

О корреляционном механизме двухуровневой рекомбинации в u , e -облученном кремнии. Дикман С. М. 8, 1427

Захват электронов на отгалкивающие кулоновский центры в германии. Бумялене С., Ясиевич И. Н. 9, 1569

Неравновесное распределение дефектов по энергиям колебаний при многофононной рекомбинации. Ясиевич И. Н., Чистяков В. М. 10, 1815

Время жизни неосновных носителей заряда в эпитаксиальных слоях $Cd_xHg_{1-x}Te$ p -типа проводимости. Мухитдинов А. М., Стафеев В. И. 10, 1830

3.2.2. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)

Долговременные релаксации проводимости, обусловленные фотостимулированной диффузией кислорода по межзеренным границам в пленках сульфида кадмия. Панов В. П., Панова Г. Д., Шейнкман М. К. 1, 95

Температурная зависимость времени релаксации фотопроводимости n - $Cd_xHg_{1-x}Te$ в микроволновом поле. Зуев В. В., Клышевич А. И., Стяпонавичюс А. А., Яковлев М. П. 1, 171

Циркулярный фотогальванический эффект в гетероузональной структуре. Абакумов В. Н., Резников Б. И., Царенков Г. В. 2, 284

Эффект усиления фототока в структурах полупроводник — туннельнопрозрачный диэлектрик — полупроводник. Вуль А. Я., Дидейкин А. Т., Бойцов С. К., Зинчик Ю. С., Саченко А. В. 2, 295

Магнитные спиновые эффекты на фотопроводимости аморфного As_2Se_3 . Кадыров Д. И.,

Минаев В. С., Франкевич Е. Л. 2, 373

Фотозлектрические свойства эпитаксиальных пленок $Pb_{1-x}Sn_xS$ и структур на их основе, обусловленные микро- и макронеоднородностями. Горшково О. В., Дрозд И. А., Стафеев В. И. 3, 510

О возможности обнаружения поверхностных состояний из спектров фотопроводимости. Аругюнян В. М., Варданян С. Х., Димаксян М. Л., Маргарян А. Л., Меликсетян В. А., Саруханян Р. Э. 3, 550

О спектральной зависимости фотопроводимости и фотомагнитного эффекта в эпитаксиальных слоях $Cd_xHg_{1-x}Te/CdTe$ с анодно-окисленной свободной поверхностью. Буянов А. В., Гасан-заде С. Г., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Романов В. А., Фридрих Е. С., Шепельский Г. А. 4, 629

Растекание нестационарного фототока в $Si<Ga>$. Винокуров Л. А., Залетаев Н. Б., Кочеров В. Ф., Фукс Б. И. 4, 770

Релаксация фотовозбужденных электронов в двойных квантовых ямах. Васько Ф. Т. 5, 825

Кинетика СВЧ фотопроводимости в подложках Si с внутренним геттером и бездефектной зоной. Короткевич А. В., Никитин В. А., Эйдельман Б. Л. 5, 942

Характеристики фотопроводимости и фотомагнитного эффекта в кристаллах $Mn_xHg_{1-x}Te$ с анодно-окисленными поверхностями.

Гасан-заде С. Г., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Каленик В. И., Раренко И. М., Романов В. А., Шепельский Г. А. 6, 1100

Релаксация задержанной фотопроводимости в электрическом поле в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. 6, 1135

Оптоэлектронные свойства селенида цинка, легированного индием. Махний В. П., Мельник В. В., Собищанский Б. М. 6, 1140

Влияние сульфидирования на состояние поверхности и фотозлектрические свойства InP и $GaAs$. Бедный Б. И., Байдусь Н. В., Белич Т. В., Карпович И. А. 8, 1383

Температурное гашение остаточной проводимости в кристаллах селенида цинка, легированных медью. Джуади Д., Касиян В. А., Недеогло Д. Д. 8, 1433

Исследование фотозлектрических свойств пленок магнитного полупроводника $Eu_{1-x}Sm_xO$. Кабанов В. Ф. 10, 1837

Влияние структуры и фазового состава на фотозлектрические характеристики пленок $Pb_{1-x}Sn_xS(Na)$. Бакуева Л. Г., Захарова И. Б., Ильин В. И., Мусихин С. Ф. 11, 2011

Кинетика и спектр фотопроводимости гетероструктур $PbTe/Pb_{1-x}Sn_xTe$, выращенных на подложках BaF_2 . Засавицкий И. И., Матвеев А. В., Мацонашвили Б. Н., Трофимов В. Т. 12, 2031

3.3. Электронная структура и электрические свойства поверхности границ раздела и тонких пленок (PACS 73)

Температурная зависимость подвижности двумерного электронного газа, ограниченной примесным рассеянием, в гетероструктурах с широким спейсерным слоем. Пикус Ф. Г., Голант Г. В. 1, 59

Явления переноса в квантовой яме, содержащей примеси с переменной валентностью. Ляпилин И. И., Кулеев И. Г., Карягин В. В. 1, 122

Спиновое расщепление подзон размерного квантования в несимметричных гетероструктурах. Герчиков Л. Г., Субашиев А. В., 1, 131

Роль объемных глубоких центров в формировании поверхностной фотоэдс в низкоомных монокристаллах $ZnSe$. Давыдов И. А., Страхов Л. П., Целищев С. Л. 1, 159

Влияние отжига под анодным окислом на изменение состава поверхности и конверсию типа проводимости монокристаллов $p-Cd_xHg_{1-x}Te$ ($x = 0.2$). Талипов Н. Х., Попов В. П., Ремесник В. Г., Налькина З. А. 2, 310

Пограничные состояния в ограниченных полупроводниковых структурах с инвертированными зонами. Идлис Б. Г., Усманов М. М. 2, 329

Высокочувствительный датчик Холла на основе селективно-легированной гетеросистемы с

$2D$ -электронами как четырехполосника. Кадущкин В. И., Ивашова Т. А. 2, 384
«Энергетическая квазибаллистика» в микроструктурах с двумерным электронным газом. Дубровский Ю. В., Ларкин И. А., Морозов С. В. 3, 522

Фотоиндуцированное образование центров поверхностной рекомбинации в арсениде галлия. Лукас А. М., Ушаков В. В., Гиппиус А. А., Марков А. В. 3, 525

Осцилляция Шубникова—де-Гааза двумерного электронного газа в двумерном периодическом потенциале. Гусев Г. М., Квон З. Д., Бесман В. Б., Вильмс П. П., Коваленко Н. В., Мошегов Н. Т., Горюпов А. И. 3, 539

Особенности электрофизических характеристик тонких слоев PbS с низким содержанием окислителя. Бурлак А. В., Зотов В. В., Игнатов А. В., Тюрин А. В., Цукерман В. Г. 3, 548

Исследование объемных и поверхностных кинетических свойств кристаллов $n-Hg_{1-x}Cd_xTe$ в области температур $0.5 < T < 50$ К. Вертий А. А., Горбатов И. Н., Иванченко И. В., Попенко Н. А., Пустыльник О. Д., Раренко И. М., Тарстапов С. И. 4, 585

- Эффекты фононного узкого горла» при разогреве носителей заряда в полупроводниковых микроструктурах. Пицалко В. Д., Толстихин В. И. 4, 602
- Переход от гетероструктур первого типа к гетероструктурам второго типа в системе InAs/InAsSbP. Гусев О. Б., Бреслер М. С., Зотова Н. В., Стусь Н. М. 4, 738
- Эффекты экранировки при образовании квазиодномерных каналов. Петросян С. Г., Шик А. Я. 4, 763
- Влияние процессов ионизации примесей на проводимость сверхрешетки в немонокристаллическом поле. Крючков С. В., Сырдоев Г. А. 4, 774
- Стимулирование магнитным полем осцилляции стационарной ЭДС в системе вырожденных $2D-3D$ -электронов. Кадушкин В. И. 5, 806
- Электронная $2D-3D$ -система — квантовый диод. I. Общие свойства. Кадушкин В. И., Фомичев С. И. 5, 811
- Вольт-фарадные характеристики тонкопленочных структур n -GaAs. Горев Н. Б., Костылев С. А., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т. 5, 861
- Зонная структура короткопериодических сверхрешеток III типа. Герчиков Л. Г., Субашин А. В., Далла Салман. 5, 882
- Электрические свойства контакта модифицированный—немодифицированный стеклообразный As_2Se_3 . Аверьянов В. Л., Звонарева Т. К., Любин В. М. 5, 918
- Электронная структура слоистых полупроводниковых кристаллов иодида таллия. Крочук А. С., Китык И. В., Колинько Н. И. 6, 1028
- Граничные условия для функции распределения электронов в полупроводниковых субмикронных пленках в теории термоэлектричества. Логвинов Г. Н. 6, 1104
- Полупроводниковые структуры с δ -слоями (обзор). Шик А. Я. 7, 1161
- Свойства поверхности и структура энергетических зон соединений A^mB^m симметрий D_{3d}^h и C_{2v}^h . Сырбу Н. Н., Стамов И. Г., Камерцель А. Ю. 7, 1191
- Затухание квантования Ландау как метод идентификации механизмов релаксации $2D$ -электронов. Кадушкин В. И. 7, 1232
- Вольт-фарадные характеристики гетероструктур с селективным легированием при наличии глубоких центров. Горев Н. Б., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т., Эппель В. И. 7, 1339
- Нестабильность проводимости, вызванная электрическим нарушением электронно-молекулярного равновесия в приповерхностном слое пленок CdS. Панов В. П., Панова Г. Д. 7, 1351
- Низкотемпературная подвижность $2MЭГ$ и качество гетерограницы в гетероструктурах InGaAs/InP, выращенных жидкофазной эпитаксией. Крещук А. М., Новиков С. В., Савельев И. Г. 8, 1375
- Влияние сульфидирования на состояние поверхности и фотозлектрические свойства InP и GaAs. Бедный Б. И., Байдусь Н. В., Белич Т. В., Карпович И. А. 8, 1383
- Электронный g -фактор в квантовых ямах и сверхрешетках. Ивченко Е. Л., Киселев А. А. 8, 1471
- Характеристика и особенности проводимости приповерхностных δ -легированных слоев в GaAs при изменении концентрации двумерных электронов. Котельников И. Н., Кокин В. А., Медведев Б. К., Мокеров В. Г., Ржанов Ю. А., Анохин С. П. 8, 1462
- Множественная полосковая структура с квазиодномерным электронным энергетическим спектром. Гродненский И. М., Дикаев Ю. М., Руденко А. С., Старостин К. В., Яссен М. Л., Медведев Б. К., Мокеров В. Г., Слепнев Ю. В. 9, 1521
- Статическое экранирование в инверсионном слое. Зебрев Г. И. 9, 1550
- Отрицательное продольное магнитосопротивление δ -легированных слоев GaAs. Буданцев М. В., Квон З. Д., Погосов А. Г. 9, 1565
- Особенности дрейфа носителей тока, рассеивающихся на двумерных оптических фононах в сильнонеравновесном стационарном состоянии. Смирнов А. Ю. 9, 1662
- Сульфидная пассивация поверхности арсенида индия. Кудрявцев Ю. А., Новиков Е. Б., Стусь Н. М., Чайкина Е. И. 10, 1742
- К теории захвата дырок квантовой ямой в полупроводниках типа GaAs. Вергелес М. В., Меркулов И. А. 10, 1784
- Фотозлектронные явления в слоях GaAs с встроенной на поверхности квантовой гетероямой. Карпович И. А., Алешкин В. Я., Аншон А. В., Байдусь Н. В., Батукова Л. М., Звонков Б. Н., Планкина С. М. 11, 1886
- Электронные состояния поверхности InP, модифицированной обработкой в парах серы. Бедный Б. И., Суслow Л. А., Байдусь Н. В., Карпович И. А. 11, 1984
- Рассеяние электронов в многобарьерных структурах GaAs/Al_xGa_{1-x}As. Гриняев С. Н., Чернышов В. Н. 12, 2057

3.3.1. Контактные явления (PACS 73.30; 73.40)

Вольт-амперная характеристика МОП транзистора с учетом зависимости подвижности от продольного электрического поля. Зебрев Г. И. 1, 83

Вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики кремниевых ПДП структур с толщиной диэлектрика менее 50 ангстрем. Вуль А. Я., Дидейкин А. Т., Осипов

- В. Ю., Бойцов С. К., Зинчик Ю. С., Макарова Т. Л. 1, 146
- Эффект усиления фототока в структурах полупроводник—туннельно-прозрачный диэлектрик—полупроводник. Вуль А. Я., Дидейкин А. Т., Бойцов С. К., Зинчик Ю. С., Саченко А. В. 2, 295
- Контактная эксклюзия в полупроводниках с анизотропной биполярной проводимостью. Акопян А. А., Витусевич С. А., Гуга К. Ю., Малютенко В. К., Рыбак А. М. 2, 389
- Термозд в полупроводниковых субмикронных пленках. Логвинов Г. Н. 3, 461
- Ложные пики в спектрах DLTS планарных диодных структур. Ремиш В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 3, 477
- Усиление фотолюминесценции в структурах n - p - $CdSiAs_2$ - n - In_2O_3 . Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Сергинов М. 3, 506
- Свойства n^+ - p -переходов на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$, подвергнутых локальной деформации. Вирт И. С., Белотелов С. В. 3, 565
- Исследование параметров зонной структуры приповерхностных слоев бесцелевых полупроводников ($CdHg$)Te и HgTe методом эффекта поля в электролитах. Яфясов А. М., Перепелкин А. Д., Божевольнов В. Б. 4, 636
- Методика определения разрыва зон на гетерогранице по измерениям вольт-фарадных характеристик m - s -гетероструктуры. Бычковский Д. Н., Константинов О. В., Панахов М. М. 4, 653
- Особенности туннелирования в барьерах Шоттки на основе узкощелевого полупроводника p - $Hg_{1-x}Cd_xTe$. Завьялов В. В., Раданцев В. Ф., Дерябина Т. И. 4, 691
- Экранирование поля в p - i - n -структурах на основе арсенида галлия при приложении напряжения обедняющей полярности. Ильинский А. В., Куценко А. Б., Степанова М. Н. 4, 710
- Гетеропереходы $ZnTe$ - PbS . Андрухив М. Г., Григорович Г. М., Бочкарева Л. В., Жляп Г. М., Шкумбатюк П. С. 4, 761
- Определение пространственного расположения локализованных электронных состояний у границы раздела полупроводник—диэлектрик. Гольдман Е. И. 4, 766
- Спиновая структура пограничных состояний и циркулярный фотогальванический эффект в гетеропереходах. Кисин М. В. 5, 785
- О механизме образования области пространственного заряда в МОП транзисторе при температуре 4.2 К. Охонин С. А., Французов А. А. 5, 832
- Управление вольт-амперными характеристиками трех связанных резонансно-туннельных диодов. Кальфа А. А., Крюков А. Р., Тагер А. С. 5, 896
- Влияние заряда, встроенного в изотипный гетеропереход, на вольт-фарадные характеристики барьерной структуры. Бычковский Д. Н., Константинов О. В. 5, 921
- Процессы токопереноса в гетероструктуре In_2O_3 - $ZnSe$ - In с субмикронным слоем селенида цинка. Беляев А. П., Рубец В. П., Тошходжаев Х. А. 5, 935
- Нелинейные свойства ВАХ и ВФХ для стенки из зараженных дислокаций. Шикина Ю. В., Шикин В. Б. 6, 992
- Баллистическая электропроводность ограниченного туннельного контакта двух квантовых ям. Грибников З. С. 6, 996
- Вольт-амперные характеристики диодов Шоттки со слоем слабо легированного полупроводника в области пространственного заряда. Кальфа А. А., Чикун В. В. 6, 1024
- Влияние накопления неосновных носителей в p^+ -слое на процесс восстановления напряжения на p^+ - n -переходе. Кардо-Сысов А. Ф., Попова М. В., Шеметило Д. И. 6, 1048
- Влияние лазерного отжига на электрические характеристики МДП структур на основе GaAs. Воронков В. П., Колыгина В. М., Муленков С. Ю., Оборина Е. И., Сальман Е. Г., Смирнова Т. П. 6, 1120
- Эффекты туннелирования квазичастиц в структурах на основе гетеропереходов второго типа. Захарова А. А., Рыжий В. И. 7, 1182
- Ударная ионизация и лавинный пробой в p - n -переходах, находящихся в неоднородном температурном поле. Добровольский В. Н., Романов А. В. 8, 1361
- Образование электронно-дырочных пар и лавинный пробой p - n -перехода при градиентах дрейфовых скоростей электронов и дырок. Добровольский В. Н., Грязнов С. Б. 8, 1366
- Изменение электронных свойств системы Si - SiO_2 при лазерном облучении. Кириллова С. И., Моин М. Д., Примаченко В. Е., Свечников С. В., Чернойко В. А., Дубров И. Н. 8, 1399
- Фотоэффект в структуре металл—полупроводник—металл на основе высокоомного полупроводника. Кашерининов П. Г., Резников Б. И., Царенков Г. В. 8, 1480
- Полевая и ударная ионизация глубоких энергетических уровней в полевых транзисторах на гетероструктурах с селективным легированием. Кальфа А. А., Пашковский А. Б., Тагер А. С. 9, 1574
- Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктур, полученных структурным переходом Au - p - InP - Au - n - In_2O_3 - p - InP . Мередов М. М., Ковалевская Г. Г., Руссу Е. В., Слободчиков С. В. 9, 1590
- Эффект инверсии зон приграничных электронных состояний в сверхрешетках на базе полупроводников A В. Канцер В. Г., Леляков И. А., Малкова Н. М. 9, 1596
- Релаксация емкости в n - π - p -переходе с произвольным уровнем легирования n - и p -областей. Урманов Н. А. 9, 1635
- Флукуационные пограничные состояния в гетеропереходе. Зыков Н. В. 9, 1645
- Анализ температурной зависимости импеданса диода с неоднородной базой из переком-

- пенсионированного полупроводника. Урманов Н. А. 9, 1669
- Немонотонная изотермическая релаксация тока в $n-p-p$ -структуре, связанная с инверсией электрического поля. Урманов Н. А. 9, 1671
- Электрические и фотоэлектрические свойства диодных структур $Pd-p-p^+-InP$ и изменение их в атмосфере водорода. Ковалевская Г. Г., Мередов М. М., Руссу Е. В., Салихов Х. М., Слободчиков С. В., Фетисова В. М. 10, 1750
- Инфекционно-контактные явления в гетероструктуре на основе неупорядоченного селенида цинка. Беляев А. П., Рубец В. П., Тошходжаев Х. А., Калинин И. П. 10, 1755
- Влияние спейсер-слоев на вольт-амперную характеристику туннельно-резонансных диодов. Игнатьев А. С., Каминский В. Э., Копылов В. Б., Мокеров В. Г., Немцев Г. З., Шмелев С. С., Шубин В. С. 10, 1795
- Динамика включения Si и GaAs $p-i-n$ -диодов. Румянцев С. Л. 11, 1955
- Фотоэлектрические свойства диодов Шоттки $In-p-CuInSe_2$. Магомедов М. А., Прочухан В. Д., Рудь Ю. В. 11, 1997
- Определение электронных характеристик границ раздела полупроводник—диэлектрик по полевым зависимостям электропроводности и емкости инверсионных каналов МДП транзисторов. Веденев А. С., Гайворонский А. Г., Ждан А. Г. 12, 2017
- Динамические вольт-амперные характеристики фоточувствительных слоистых структур на основе сильно легированного $Si(As)$ с
- блокированной проводимостью по примесной зоне. Ждан А. Г., Козлов А. М., Костинская Т. А., Кочеров В. Ф., Рыльков В. В. 12, 2024
- Кинетика и спектр фотопроводимости и гетероструктур $PbTe/Pb_{1-x}Sn_xTe$, выращенных на подложках BaF_2 . Засавицкий И. И., Матвеев А. В., Моцонашвили Б. Н., Трофимов В. Т. 12, 2031
- Термическая генерация неосновных носителей заряда у границы раздела полупроводник—диэлектрик через глубокий уровень в приповерхностном слое обеднения. Гольдман Е. И., Ждан А. Г., Сумарока А. М. 12, 2048
- Баллистическая проводимость квантовой ямы с туннельно-резонансным отражателем. Вагидов Н. З., Грибников З. С. 12, 2068
- Контактный потенциал квантовой ямы в полупроводниковой гетероструктуре. Бычковский Д. Н., Воронцова Т. П., Константинов О. В. 12, 2118
- Сильнополевое заполнение глубоких уровней в гетероструктурных полевых транзисторах с модулированным легированием ($AlGaAs/GaAs$). Мальцев С. В., Принц В. Я. 12, 2133
- Неравновесное излучение при эксклюзии в полупроводниках с наведенной анизотропией проводимости. Гуга К. Ю., Малютенко В. К., Рыбак А. М. 12, 2141
- Кинетика установления эксклюзии в p^+-p -структурах Ge с наведенной магнитным полем анизотропной проводимостью. Гуга К. Ю., Илющенко И. Ю. 12, 2146

3.4. Магнитные свойства полупроводников, магнитные резонансы (PACS 75.76)

- Энергия связи экситонов в магнитосмешанных полупроводниках в магнитном поле. Семенов Ю. Г., Стефанович В. А. 2, 324
- Магнитные спиновые эффекты на фотопроводимости аморфного As_2Se_3 . Кадыров Д. И., Минаев В. С., Франкевич Е. Л. 2, 373
- Электронный g -фактор в квантовых ямах и сверхрешетках. Ивченко Е. Л., Киселев А. А. 8, 1471
- Спектр мелкого акцептора в полумагнитном полупроводнике в магнитном поле. Иванов-Омский В. И., Харченко В. А., Цыпишка Д. И. 10, 1728
- Исследование фотоэлектрических свойств пленок магнитного полупроводника $Eu_{1-x}Sn_xO$. Кабанов В. Ф. 10, 1837
- Циклотронный резонанс в сверхрешетках $(GaAs)_n(InAs)_m$. Шегай О. А., Мошегов Н. Т., Палкин А. М., Торопов А. И. 11, 1987
- Проявление механических напряжений в электронном парамагнитном резонансе гетеросистем на основе соединений $Al^{IV}V^{VI}$, легированных примесью марганца. Ройцин А. Б., Пляцко С. В., Громовой Ю. С., Климов А. А., Кадышев С. К. 12, 2091
- Применение метода насыщения сигналов электронного парамагнитного резонанса для исследования аморфного гидрированного карбида кремния переменного состава. Карягин С. Н., Константинова Е. А. 12, 2129

3.5. Оптические свойства полупроводников. Взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)

- Получение и исследование пленок SiO_2 , активированных полупроводниковыми нанокристаллами CdS . Гуревич С. А., Екимов А. И., Кудрявцев И. А., Осинский А. В., Скопина В. И., Чепик Д. И. 1, 102
- Температурная зависимость времени релаксации фотопроводимости $n-Cd_xHg_{1-x}Te$ в микроволновом поле. Зуев В. В., Клышевич А. И., Стяпановичюс А. А., Яковлев М. П. 1, 171

- Радиоэлектрический эффект в сверхрешетках в импульсном режиме облучения. Вязовский М. В., Крюков С. В. 1, 184
- Влияние утоньшения подложки на оптические свойства эпитаксиальных слоев арсенида галлия (эффект дальнего действия). Кладько В. П., Крыштаб Т. Г., Клейнфельд Ю. С., Семенова Г. Н., Хазан Л. С. 2, 368
- Образование глубоких центров в GaAs при лазерном облучении. Дмитриев А. Г., Дорин В. А., Карфул Р., Погарский М. А., Шульга М. И. 2, 397
- Спектры испускания силикатного пористого стекла, возбуждаемые лазерным излучением в области прозрачности SiO₂. Бегер В. Н., Земский В. И., Сечкарев А. В. 5, 911
- Кинетика СВЧ фотопроводимости в подложках Si с внутренним геттером и бездефектной зоной. Короткевич А. В., Никитин В. А., Эйдельман Б. Л. 5, 942
- Влияние сильного СВЧ поля на фотоэлектрические характеристики кремниевых *p-n*-переходов. Аблязимова Н. А., Вейнгер А. И., Питанов В. С. 6, 1041
- Исследование оптических характеристик эпитаксиальных слоев (100), выращенных методами молекулярно-лучевой эпитаксии и газофазной эпитаксии. Коваленко А. В.,
- Мекекекчю А. Ю., Боднарь Н. В., Тищенко В. В., Шекочихин Ю. М., Руянцева С. М., Малащенко И. С. 7, 1251
- Анизотропия оптического отражения арсенида галлия в области края фундаментального поглощения. Берковиц В. Л., Гусев А. О., Львова Т. В. 7, 1264
- Спектральные характеристики варизонных структур с нелинейным профилем состава. Клецкий С. В. 9, 1631
- Позитроний в полупроводниковых структурах с квантовыми ямами. Прокопьев Е. П. 10, 1681
- Исследование лазерного геттерирования в GaAs методами фотолюминесценции и нарушенного полного внутреннего отражения. Бобицкий Я. В., Берча А. И., Дмитрук Н. Л., Корбутяк Д. В., Фидря Н. А. 10, 1688
- Модификация коэффициента отражения полупроводников A^{III}B^V при импульсном лазерном облучении. Кашкаров П. К., Русина М. В., Тимошенко В. Ю. 10, 1835
- Влияние магнитного поля на поляризацию теплового излучения изотропных полупроводников. Коллюх А. Г., Мороженко В. А. 12, 2107

3.5.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)

- Поглощения на связанных и свободных экситонах в ZnP₂—D₂. Сырбу Н. Н., Морозова В. И., Стратан Г. И. 1, 74
- Влияние ионной имплантации компенсирующей примеси на оптические свойства *n*-GaAs. Венгер Е. Ф., Гончаренко А. В., Дмитрук Н. Л., Прокопьев А. Ю., Фидря Н. А. 2, 352
- Многофотонное межзонное поглощение лазерного излучения в полупроводниках с участием примесных уровней. Катана П. К. 3, 578
- Тонкая структура A-линии связанного экситона в твердом растворе GaAs_xP_{1-x}:N. Глинский Г. Ф., Лупал М. В., Парфенова И. И., Пихтин А. Н. 4, 644
- Силы осцилляторов оптических переходов в мелких примесях и примесных комплексах в кремнии и германии. Андреев Б. А., Козлов Е. Б., Лифшиц Т. М. 5, 927
- Фотоэлектрический метод определения коэффициента оптического поглощения и его применение к полуизолирующему GaAs. Карпович И. А., Планкина С. М. 7, 1313
- Экситонная структура края фундаментального поглощения CuInSe₂. Абдуллаев М. А. 12, 2131

3.5.2. Комбинационное рассеяние (PACS 78.30)

- Рамановские и ИК колебательные спектры в кристаллах TiGaS₂. Сырбу Н. Н., Львин В. Э., Заднипру И. Б., Нойманн Х., Собога Х., Риеде В. 2, 232
- Фонон-плазмонные моды в спектрах комбинационного рассеяния света эпитаксиальных слоев *n*-Al_xGa_{1-x}As. Минтаиров А. М., Смекалин К. Е., Устинов В. М., Хвостиков В. П. 4, 614
- Спектроскопия КРС ионно-имплантированных слоев GaAs. Артамонов В. В., Валах М. Я., Громашевский В. Л., Нечипорук Б. Д., Стрельчук В. В., Юхимчук В. А. 4, 725
- Спектры комбинационного рассеяния и фазовые переходы в AgAsS₂ под давлением. Курыева Р. Г., Киркинский В. А. 4, 730
- Деполаризация колебательных мод в кристаллах CdGa₂Se₄. Сырбу Н. Н., Тэзлован В. Е., Заднипру И. Б. 7, 1225
- Колебательные спектры и эффективные ионные заряды в кристаллах AgAsS₂ и TlAsS₂. Сырбу Н. Н., Пасечник Ф. И. 10, 1701

- Магнитофотолюминесценция узкощелевого полупроводника $\text{Hg}_{0.77}\text{Cd}_{0.23}\text{Te}$. Иванов-Омский В. И., Петров И. А., Смирнов В. А., Ястребов С. Г. 2, 305
- Фотолюминесценция эпитаксиального слоя InSb на квазиполуизолирующей подложке $p\text{-InSb}$. Иванов-Омский В. И., Смирнов В. А., Юлдашев Ш. У., Гадаев О. А., Стрэдлинг Р. А., Фергюсон И. 3, 413
- Природа нестабильности свечения в светоизлучающих GaP:N-структурах. Торчинская Т. В., Бердинских Т. Г., Смиян О. Д. 3, 454
- Рекомбинационное излучение варизонных полупроводников в условиях магнитоконцентрационного эффекта. Савицкий В. Г., Соколовский Б. С., Новак В. И. 3, 571
- Электролюминесценция в $p-i-n$ -структурах на основе $\alpha\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x$: Н. Жерздев А. Б., Карпов В. Г., Пестцов А. Б., Пилатов А. Г., Феоктистов Н. А. 4, 750
- Деформационно-стимулированное изменение концентрации излучающих центров в арсениде галлия. Городинченко О. К., Коваленко В. Ф., Прохорович А. В. 4, 759
- Фотолюминесценция сильно легированного арсенида галлия при упорядоченном распределении примесных комплексов. Богданова В. А., Семиколенова Н. А. 5, 818
- Излучательная и безызлучательная рекомбинация в четверных твердых растворах $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}_{1-y}\text{Te}_y$. Даварашвили О. И., Караваев Г. Ф., Катаев С. Г., Тютюрев В. Г. 5, 906
- К вопросу о природе полосы излучения (1.23—1.25) эВ в спектре люминесценции кристаллов GaAs(Te). Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. 5, 958
- Фотолюминесценция компенсированного SiC-6H . Евстропов В. В., Линьков И. Ю., Морозенко Я. В., Пикус Ф. Г. 6, 969
- Низкотемпературная фотолюминесценция монокристаллических слоев $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$, полученных твердофазным замещением. Бабенцов В. Н., Горбань С. И., Евтухов Ю. Н. 6, 1063
- Симметрия комплекса VGaTeAs в GaAs и его переориентация при низких температурах. Аверкиев Н. С., Гуткина А. А., Осипов Е. Б., Решиков М. А., Сосновский В. Р. 7, 1269
- Фотолюминесценция эпитаксиальных слоев $\text{Zn}_x\text{CdyHg}_{1-x-y}\text{Te}$. Андрухив А. М., Гадаев О. А., Иванов-Омский В. И., Мионов К. Е., Смирнов В. А., Юлдашев Ш. У., Цидильковский Э. И. 7, 1288
- Электрические и фотолюминесцентные свойства эпитаксиальных слоев GaSb (Bi) и GaSb(Bi, Sn), полученных из висмутовых растворов. Акчурун Р. Х., Жегалин В. А., Чалдышев В. В. 8, 1409
- Фотолюминесценция в δ -легированных углеродом сверхрешетках в арсениде галлия. Алешкин В. Я., Аншон А. В., Батукова Л. М., Демидов Е. В., Демидова Е. Р., Звонков Б. Н., Карлович И. А., Малкина И. Г. 10, 1848
- Кристаллографическая ориентация и примесное свечение стримерных разрядов в монокристаллах ZnS и ZnSe. Грибковский В. П., Гладышук А. А., Гурский А. Л., Луценко Е. В., Морозов Н. К., Шульга Т. С., Яблонский Г. П. 11, 1920
- Неравновесное излучение при эксклюзии в полупроводниках с наведенной анизотропией проводимости. Гуга К. Ю., Малютенко В. К., Рыбак А. М. 12, 2141

3.5.4. Оптические свойства поверхности границ раздела тонких пленок (PACS 78.65)

- Температурная зависимость энергии связи экситонов Ванье-Мотта в квантовых ямах. Алешкин В. Я., Костин А. А., Романов Ю. А. 2, 318
- Междупозонное поглощение ИК излучения в напращенных структурах $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}-\text{GaAs}$ с квантовыми ямами. Алешкин В. Я., Аншон А. В., Бабушкина Т. С., Батукова Л. М., Демидов Е. В., Звонков Б. Н., Кунцевич Т. С., Малкина И. Г., Янькова Т. Н. 3, 516
- Оптические гетероконтакты на основе пленок CuInSe_2 . Константинова Н. Н., Магомедов М. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. 3, 558
- Полупроводниковые структуры с δ -слоями (обзор). Шик А. Я. 7, 1161
- Экситонные, внутрицентровые и структурно-дефектные переходы в квазидвумерных кристаллах $\text{TlGaS}_2:\text{Nd}_2\text{S}_3$. Абуталыбов Г. И., Джафарова С. З., Рагимова Н. А., Мехтиев Э. И. 9, 1643
- Электрон-фононный механизм уширения оптических полос поглощения в квазиульмерных кристаллах. Коварский В. А., Чиботарь В. Н. 10, 1828
- Поляризационная фоточувствительность тонкопленочных структур $p\text{-CuInSe}_2-l\text{-CdS}$. Константинова Н. Н., Магомедов М. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. 11, 1861
- Интерференционные эффекты в спектрах фотоионизации структур с квантовыми ямами. Долманов И. Н., Марков А. К., Толстихин В. И. 11, 1899
- Определение однородности квантовых ям на основе InGaAs/GaAs по фотомодуляционным спектрам. Авруцкий И. А., Осауленко О. П., Плотниченко В. Г., Пырков Ю. Н. 11, 1907
- Влияние магнитного поля на линейную поляризацию фотолюминесценции горячих электронов в квантовых ямах. Перель В. И., Портной М. Е. 12, 2112

4.1. Методы получения, термообработка и травление полупроводников (PACS 81)

- Кинетика окисления кремния и структура окисных слоев толщиной менее 50 ангстрем. Вуль А. Я., Макарова Т. Л., Осипов В. Ю., Зинчик Ю. С., Бойцов С. К. 1, 111
- Влияние компенсирующего отжига на шум $1/f$ в $Cd_xHg_{1-x}Te$. Бакши И. С., Карачевцева Л. А., Любченко А. В., Петряков В. А., Сальков Е. А., Хижняк Б. И. 1, 173
- Влияние отжига под анодным окислом на изменение состава поверхности и конверсию типа проводимости монокристаллов $p-Cd_xHg_{1-x}Te$ ($x \approx 0.2$). Талипов Н. Х., Попов В. П., Ремесник В. Г., Налькина З. А. 2, 310
- Образование глубоких центров в GaAs при лазерном облучении. Дмитриев А. Г., Дорин В. А., Карфул Р., Погарский М. А., Шульга М. И. 2, 397
- Образование и свойства термодоноров при отжиге ниже $550^\circ C$ в кристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского. Бабич В. М., Баран Н. П., Доценко Ю. П., Зотов К. И., Ковальчук В. Б., Максименко В. М. 3, 447
- Получение и свойства изотипных гетероструктур на основе $n-CuInSe_2$. Магомедов М. А., Медведкин Г. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. 3, 556
- Твердофазное лазерное легирование монокристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$. Вирт И. С., Кузьма М. С., Шерегий Е. М., Шкумбатьюк П. С. 3, 562
- Кинетика образования термодоноров в кристаллах Si (Ge, O). Бринкевич Д. И., Маркевич В. П., Мурин Л. И., Петров В. В. 4, 682
- Влияние избыточного давления паров компонентов на ансамбль точечных дефектов в кристаллах CdS. Крюкова И. В., Теплицкий В. А., Шульга Е. П., Джумаев Б. Р., Корсунская Н. Е. 6, 1054
- Исследование преобразования дефектов в кристаллах CdTe при кратковременном отжиге методом люминесценции профилирования. Бабенцов В. Н., Рашковецкий Л. В., Сальков Е. А., Тарбаев Н. И. 6, 1088
- Влияние лазерного отжига на электрические характеристики МДП структур на основе GaAs. Воронков В. П., Колыгина В. М., Муленков С. Ю., Оборина Е. И., Сальман Е. Г., Смирнов Т. П. 6, 1120
- Исследование оптических характеристик эпитаксиальных слоев ZnSe/GaAs (100), выращенных методами молекулярно-лучевой эпитаксии и газофазной эпитаксии. Коваленко А. В., Мекекешко А. Ю., Бондарь Н. В., Тищенко В. В., Шекочихин Ю. М., Румянцева С. М., Малашенко И. С. 7, 1251
- Лазерно-стимулирующая диффузия золота в кремнии. Закиров А. С., Игамбердыев Х. Т., Мамадалимов А. Т., Хабибуллаев П. К. 7, 1282
- Модификация спектра мелких состояний арсенида галлия под действием импульсного лазерного излучения. Кашкаров П. К., Тимошенко В. Ю. 7, 1321
- Низкотемпературная подвижность $2M\Omega$ и качество гетерограницы в гетероструктурах InGaAs/InP, выращенных жидкофазной эпитаксией. Крещук А. М., Новиков С. В., Савельев И. Г. 8, 1375
- Изменение электронных свойств системы Si-SiO₂ при лазерном облучении. Кириллова С. И., Моин М. Д., Примаченко В. Е., Свечин С. В., Черновой В. А., Дубров И. Н. 8, 1399
- О механизме отжига дивакансий в кремнии, облученном протонами. Берман Л. С., Воронков В. Б., Козлов В. А., Ременюк А. Д. 8, 1507
- Влияние предварительной термообработки на эффективность образования радиационных дефектов в бездислокационном кремнии. Лукаков П. Ф., Лукьянидз В. В. 8, 1509
- Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктур, полученных структурным переходом Au-p-InP-Au-n-In₂O₃-p-InP. Мередов М. М., Ковалевская Г. Г., Руссу Е. В., Слободчиков С. В. 9, 1590
- Влияние отжига на спектр глубоких центров захвата в ZnSe. Окочечников А. П., Мельник Н. Н. 9, 1659
- Полосковые зарощенные AlGaAs-гетеролазеры, полученные методом жидкофазной эпитаксии в одностадийном процессе. Казанцев А. Б., Ларионов В. Р., Румянцев В. Д., Танклевская Е. М., Хвостиков В. П. 9, 1666
- Интерпретация неравновесных емкостных спектров А-центров, вводимых при импульсной фотонной обработке кремния. Белявский В. И., Капустин Ю. А., Свиридов В. В. 10, 1832
- Модификация коэффициента отражения полупроводников А В при импульсном лазерном облучении. Кашкаров П. К., Русина М. В., Тимошенко В. Ю. 10, 1835
- О механизме ионно-индуцированной кристаллизации в кремнии. Новиков А. П., Гусаков Г. А., Комаров Ф. Ф., Толстых В. П. 10, 1841
- Влияние неравновесных собственных точечных дефектов на образование электрически активных центров в кремниевых р-n-структурах при термообработке. Выжигин Ю. В., Соболев Н. А., Грессер В. Н., Шек Е. И. 11, 1938

4.2. Применение полупроводников, полупроводниковые приборы (PACS 85)

- Вольт-амперная характеристика МОП транзистора с учетом зависимости подвижности от продольного электрического поля. Зебрев Г. И. 1, 83

Ффевтивные зеленые светодиоды на карбиде кремния. Водаков Ю. А., Вольфсон А. А., Зарицкий Г. В., Мохов Е. Н., Остроумов А. Г., Роенков А. Д., Семенов В. В., Соколов В. И., Сыралев В. А., Удалцов В. Е. 1, 107

Природа нестабильности свечения в светоизлучающих GaP: N-структурах. Торчинская Т. В., Бердинских Т. Г., Смиян О. Д. 3, 454

Теория инфракрасных фотоприемников на основе структур $n\text{-Si}-\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ с квантовыми ямами. Серженко Ф. Л., Шадрин В. Д. 3, 191

Диоды Ганна на основе гетероструктуры $n\text{-InGaAs}/n^+\text{-InP}$. Борисов В. И., Гореленок А. Т., Дмитриев С. Г., Любченко В. Е., Рехвишвили Д. Н., Рогаченко А. С. 4, 611

О влиянии неоднородности поглощения сигнального излучения на частотную характеристику высокомерного примесного фоторезистора. Блохин И. К., Холоднов В. А. 4, 742

Паразитное управление по подложке в полевых транзисторах на арсениде галлия. Гергель В. А., Ильичев Э. А., Лукьянченко А. И., Полторацкий Э. А., Шамхалов К. С. 5, 794

Ультрафиолетовые карбид-кремниевые фотоприемники. Веринчиков Р. Г., Водаков Ю. А., Литвин Д. П., Мохов Е. Н., Роенков А. Д., Санкин В. И. 6, 1008

Особенности температурных зависимостей фотоэлектрических характеристик $\alpha\text{-Si}$: Н-фотопреобразователей с зеркально отража-

ющим тыльным контактом. Манаков С. М., Таурбаев Т. И. 6, 1145

О температурном токе и шум-факторе ступенчатых ЛФД. Бегучев В. П., Мечетин А. М., Кондратьева О. Г., Неустров Л. Н. 7, 1236

Исследование биполярного двухколлекторного тензотранзистора с ускоряющим электрическим полем в базе. Бабичев Г. Г., Гузь В. Н., Жадько И. П., Козловский С. И., Романов В. А. 7, 1244

Статические характеристики тонкопленочных полевых транзисторов на основе $\alpha\text{-Si}$:Н. Греков Е. В. 7, 1256

Расчет динамических характеристик лавинно-протекного диода на карбиде кремния. Василевский К. В. 10, 1775

Светодиоды на основе карбида кремния, облученного быстрыми электронами. Водаков Ю. А., Гирка А. И., Константинов А. О., Мохов Е. Н., Роенков А. Д., Свирида С. В., Семенов В. В., Соколов В. И., Шишкин А. В. 11, 1857

Динамика включения Si и GaAs $p-i-n$ -диодов. Румянцев С. Л. 11, 1955

Пленка Ленгмюра-Блуджетт в качестве диэлектрика в МДП транзисторе на основе $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. Германенко А. В., Ларионова В. А., Миньков Г. М., Рут О. Э. 12, 2136

Некоторые аспекты применения кремния, легированного изотопом бор-11. Карумидзе Г. С., Джабова Д. Ш., Тевзадзе Г. А., Шавелашвили Ш. Ш. 12, 2138

4.3. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55)

Природа температурной зависимости пороговой плотности тока длинноволновых лазеров на основе ДГС InAsSbP/InAs и InAsSbP/InAsSb. Айдаралиев М. Ш., Зегря Г. Г., Зотова Н. В., Карандашев С. А., Матвеев Б. А., Стусь Н. М., Талалакин Г. Н. 2, 246

Высококачественная модуляция выходной мощности полупроводникового лазера на двойной гетероструктуре $n^+\text{-AlGaAs-GaAs-p}^+\text{-AlGaAs}$ греющим электрическим полем. Горфинкель В. Б., Филатов И. И. 3, 401

Динамические характеристики мощных импульсных GaAs/AlGaAs-суперлюминесцентных светодиодов. Аврутин Е. А., Корольков В. И., Орлов Н. Ю., Рожков А. В., Султанов А. М. 4, 719

Полосковые зарощенные AlGaAs-гетеролазеры, полученные методом жидкофазной эпитаксии в одностадийном процессе. Казанцев А. Б., Ларионов В. Р., Румянцев В. Д., Танклевская Е. М., Хвостиков В. П. 9, 1666

Механизм деградации (GaAs/AlGaAs)-лазера с квантовой ямой. Соболев М. М., Гитцович А. В., Папенцев М. И., Кочнев И. В., Явич Б. С. 10, 1760

Природа длинноволнового сдвига спектра когерентного излучения в гетеролазерах на основе GaInAsSb. Баранов А. Н., Белкин С. Ю., Данилова Т. Н., Ершов О. Г., Именков А. Н., Яковлев Ю. П. 11, 1971

5. Юбилей и даты

Мильвидский Михаил Григорьевич (к 60-летию со дня рождения). 8, 1517

6. Информация о новых книгах, конференциях

Первый международный симпозиум по исследованию перспективных полупроводниковых приборов (ISDRS-91). Левинштейн М. Е. 6, 1153

Рецензия на книгу Федотова Я. А. «Интегральная электроника сверхвысоких частот». Вуль А. Я. 6, 1156

Новые книги по полупроводникам. Козуб В. И. 1, 192; 7, 1355; 9, 1675